

ศูนย์บริการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักนายกรัฐมนตรี



INVESTMENT SERVICES CENTER

THE BOARD OF INVESTMENT

OFFICE OF THE PRIME MINISTER

555 ถ. วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2553 8111

555 Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak Bangkok 10900 Tel. 0 2553 8111, Fax : 0 2553 8222

ข่าวสำหรับสื่อมวลชน / PRESS RELEASE

ฉบับ 129 / 2567 (อ. 60)

วันที่ 23 กันยายน 2567

บีโอไอหนุน ฮานา - ปตท. ผุดโรงงานชิปแห่งแรกของไทย ยกระดับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำ

บีโอไอหนุนบริษัทร่วมทุน ฮานา - ปตท. เดินหน้าแผนลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิปชนิดซิลิคอนคาร์ไบด์แห่งแรกของไทย ภายในสิ้นปีนี้ หลังได้รับอนุมัติจากบีโอไอและออกบัตรส่งเสริมเมื่อเดือนสิงหาคม 2567 ลงทุนเฟสแรก 11,500 ล้านบาท เริ่มผลิตภายใน 2 ปี รองรับการผลิตของกลุ่ม Power Electronics ทั้ง EV, Data Center และระบบกักเก็บพลังงาน ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำของไทย

นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 ได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการลงทุนผลิตชิป (Wafer Fabrication) แห่งแรกของประเทศไทย ของบริษัท เอฟทีวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FT1) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ และกลุ่ม ปตท. หลังจากทีบีโอไอได้อนุมัติให้การส่งเสริมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จากนั้นบริษัทได้ดำเนินการออกบัตรส่งเสริมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บีโอไอได้ทำงานร่วมกับบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อสนับสนุนการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโรงงาน และเตรียมเริ่มก่อสร้างโรงงานในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมศรีสุทโธพัฒน จังหวัดลำพูน ภายในเดือนธันวาคมของปีนี้ โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรประมาณ 2 ปี ก่อนจะเริ่มผลิตในช่วงไตรมาสแรกของปี 2570

บริษัท เอฟทีวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะจัดตั้งโรงงานผลิตชิปต้นน้ำแห่งแรกในประเทศไทย เงินลงทุนเฟสแรกกว่า 11,500 ล้านบาท โดยรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตชิปชั้นนำของเกาหลีใต้ เพื่อผลิตชิป (Wafer) ชนิดซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) ขนาด 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว โดยมีคุณสมบัติสำคัญที่แตกต่างจากชิปทั่วไปที่ผลิตจากซิลิคอน คือ สามารถทนกระแสไฟฟ้าและความร้อนสูงได้ จึงเหมาะสมสำหรับการใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการแปลงพลังงานไฟฟ้า (Power Electronics) เช่น เครื่อง Server ใน Data Center อุปกรณ์อัดประจุ

ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า Inverter ในยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์แปลงพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต

เหตุผลสำคัญของการเลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้งของโครงการนี้ เนื่องจากข้อกำหนดหลักของลูกค้า คือ 1) ต้องตั้งในประเทศที่มีความเป็นกลางเพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ 2) มีต้นทุนที่แข่งขันได้ และ 3) มีขีดความสามารถในการขยายกำลังการผลิตในอนาคต ซึ่งประเทศไทยสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ นอกจากนี้ ไทยยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง ไฟฟ้ามีความเสถียร มีศักยภาพด้านพลังงานสะอาด บุคลากรมีคุณภาพสูง มาตรการสนับสนุนที่ดีจากภาครัฐ อุตสาหกรรมรถยนต์ EV ระบบกักเก็บพลังงาน และ Data Center ที่กำลังเติบโตสูง อีกทั้งโรงงานของฮานาฯ ในไทย มีการประกอบกิจการที่ต่อเนื่องจากการผลิตชิปอยู่แล้ว โดยเฉพาะขั้นตอนการประกอบและทดสอบวงจรรวม (IC Assembly and Testing)

“อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายต่าง ๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล โทรคมนาคม ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ที่ผ่านมามีบทบาทของไทยอยู่ในชั้นกลางน้ำ คือ การรับจ้างประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ หรือที่เรียกว่า OSAT โครงการลงทุนผลิตชิปครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำ นอกจากจะช่วยสร้างงานและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยในไทยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเซมิคอนดักเตอร์จากเกาหลีใต้แล้ว ยังจะส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เข้าสู่ซัพพลายเชนของเซมิคอนดักเตอร์ และนำไปสู่การพัฒนาาระบบนิเวศของอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ซึ่งจะช่วยให้สามารถดึงดูดผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำรายอื่น ๆ ให้เข้ามาลงทุนในไทยอีกด้วย” นายณัฐม์ กล่าว

“บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน”

